



ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

KD617;TESLA;TO3; tranzystor; PNP;10A;80V;70W;2MHz



Dane techniczne:

Nazwa: KD617

Typ tranzystora: bipolarny

Kierunek przewodnictwa: PNP

Prąd kolektora: 10A

Napięcie kolektor-emiter: 80V

Moc: 70W

Częstotliwość: 2MHz

Montaż: przewlekany(THT)

Obudowa: TO3

Producent: Tesla

www.podzespoly-elektroniczne.pl

Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 / sklep@podzespoly-elektroniczne.pl

A.F. POWER TRANSISTOR N-P-N

NF-LEISTUNGSTRANSISTOREN N-P-N

Type Typ	Maximum ratings ● Grenzdaten						at U_{CB}		h_{21E} at bei	U_{CB} V	I_C A	$U_{BE sat}$ U_{BE}^* U_{BE}^{max} V	$U_{CE sat}$ max V	f_T min MHz	Case Gehäuse
	U_{CEO}	U_{EBO}	I_C	I_B	P_{tot}	ϑ_j	I_{CBO} I_{CER}^* I_{CER}^{max} mA	U_{CE}^* bei U_{CE}^* V							
	V	V	A	A	W	°C									
KD501	40	5	20	7	150 ³⁾	155	0,5 10*	40 50*	> 40 > 15	2 2	1 15	— 1,7 ¹⁾	— 0,75 ¹⁾	2 —	T41
KD502	60	5	20	7	150 ³⁾	155	0,5 10*	60 50*	> 40 > 15	2 2	1 15	— 1,7 ¹⁾	— 0,75 ¹⁾	2 —	T41
KD503	80	5	20	7	150 ³⁾	155	0,5 10*	80 50*	> 40 > 15	2 2	1 15	— 1,7 ¹⁾	— 0,75 ¹⁾	2 —	T41
KD601	24	5	10	1	35 ⁴⁾	200	10	24	> 1 ⁷⁾	6	0,1	2,4 ¹⁾	1,3 ²⁾ 2,4 ¹⁾	10	T37
KD602	110 ³⁾	5	8	1	35	155			15 ... 50	2	4	2,4 ³⁾	2 ³⁾	0,5	T37
KD605	40	5	10	2	70 ⁶⁾	155	0,5	40	> 30 > 10	2 2	1 10	— 2,4 ¹⁾	— 2 ¹⁾	2 —	T39
KD606	60	5	10	2	70 ⁶⁾	155	0,5	60	> 30 > 10	2 2	1 10	— 2,4 ¹⁾	— 2 ¹⁾	2 —	T39
KD607	80	5	10	2	70 ⁶⁾	155	0,5	80	> 30 > 10	2 2	1 10	— 2,4 ¹⁾	— 2 ¹⁾	2 —	T39
KD3055	60	7	15	7	117	200	0,7*	30*	20 ... 70 > 5	4 4	4 10	1,8*	1,1 ⁹⁾ 5,0 ¹⁰⁾	1	T42
KD3442	140	7	10		117	200	1,0	140	20 ... 70 > 7,5	4 4	3 10	1,7* ¹¹⁾ 5,7* ¹²⁾	1,0 ¹¹⁾ 5,0 ¹²⁾	1	T42
KD3772	60	7	20	5	150	200	5,0	100	15 ... 60	4	10	2,2*	1,4 ¹⁾	1	T42
KD3773	140	7	16	4	150	200	10	120	15 ... 60 > 5	4 4	8 16	2,2*	4,0 ¹³⁾	1	T42
KD4348	120	7	10	4	120	200	10	100	15 ... 60 > 10	4 4	5 10	2,0*	2,0 ¹⁴⁾	1	T42

1) $I_C = 4$ A, $I_B = 1$ A2) $I_C = 4$ A, $I_B = 0,1$ A3) $I_C = 8$ A, $I_B = 0,8$ A4) $\vartheta_c \leq 45$ °C5) at ● bei $U_{CE} = 30$ V, $\vartheta_c = 100$ °C, $P_C = 65$ W } can not occur a second breakdown ●6) at ● bei $U_{CE} = 30$ V, $\vartheta_c = 25$ °C, $P_C = 70$ W } darf nicht Sekundär-Durchbruch eintreten7) $f = 10$ MHz8) U_{CEV} ; $I_{CE} = 10$ mA, $-U_{BE} = 0,8$ V9) $I_C = 4$ A, $I_B = 0,4$ A10) $I_C = 10$ A, $I_B = 3,3$ A11) $I_C = 3$ A, $I_B = 0,3$ A12) $I_C = 10$ A, $I_B = 2,0$ A13) $I_C = 16$ A, $I_B = 3,2$ A14) $I_C = 10$ A, $I_B = 1,25$ A

A.F. POWER TRANSISTORS P-N-P

NF-LEISTUNGSTRANSISTOREN P-N-P

Type	Maximum ratings ● Grenzdaten						$-I_{CBO}$	at	$-U_{CB}$	h_{21E}	at	$-U_{CE}$	$-I_C$	$-U_{BES}$	$-U_{CES}$	f_T	Case Gehäuse
Typ	$-U_{CEO}$	$-U_{EBO}$	$-I_C$	$-I_B$	P_{tot}	ϑ_j	max	bei			bei			max 1)	max 1)	min	
	V	V	A	A	W	°C	mA		V			V	A	V	V	MHz	
KD615	40	5	10	2	70	155	1,0		40	> 30 > 10		2 2	1 10	2,4	2	2	T39
KD616	60	5	10	2	70	155	1,0		60	> 30 > 10		2 2	1 10	2,4	2	2	T39
KD617	80	5	10	2	70	155	1,0		80	> 30 > 10		2 2	1 10	2,4	2	2	T39

1) $-I_C = 10$ A, $-I_B = 1$ A